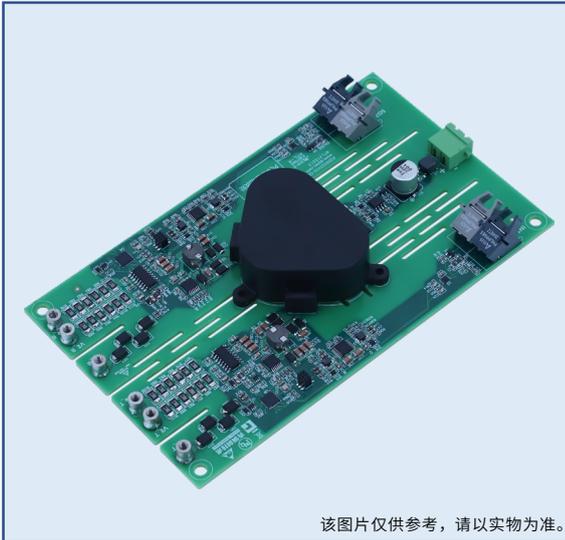


2QD0325V33-QSFA 驱动器



该图片仅供参考，请以实物为准。

特征

- 双通道 IGBT 驱动器
- 设计紧凑，尺寸为 68mm*99.5mm
- 电源电压输入宽范围 +14V~+30V
- 光纤接口输入 / 输出
- 绝缘电压高达 8000V
- 集成有源钳位
- 集成副边电源欠压保护 (UVLO)
- 集成 VCE 短路保护

RoHS
COMPLIANT

[第 07 页](#)

[第 08 页](#)

主要参数

V _{CC}	25V
V _G	+15V, -10V
P, MAX	3W
I _G , MAX	±25A
f _s , MAX	5kHz
T _A	-40°C ~85°C
绝缘耐压	8000Vac

描述

2QD0325V33-QSFA 是一款适配 IGBT 模块的紧凑型双通道高绝缘等级的驱动器，针对高可靠性的大功率中压领域设计而成。

2QD0325V33-QSFA 适用 ABB 5SND 0500N330300 或中车时代半导体 TIM500GDM33-PSA011 模块搭建的多种拓扑方案。

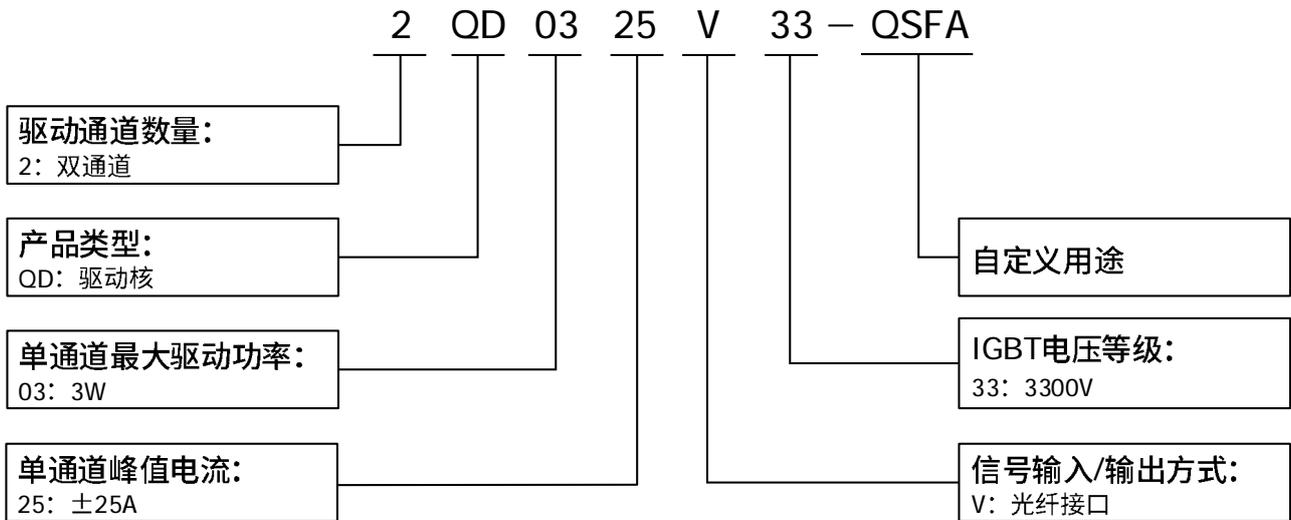
典型应用

- 风电变流器
- 光伏逆变器
- 中压变流器
- 电机传动
- 牵引传动

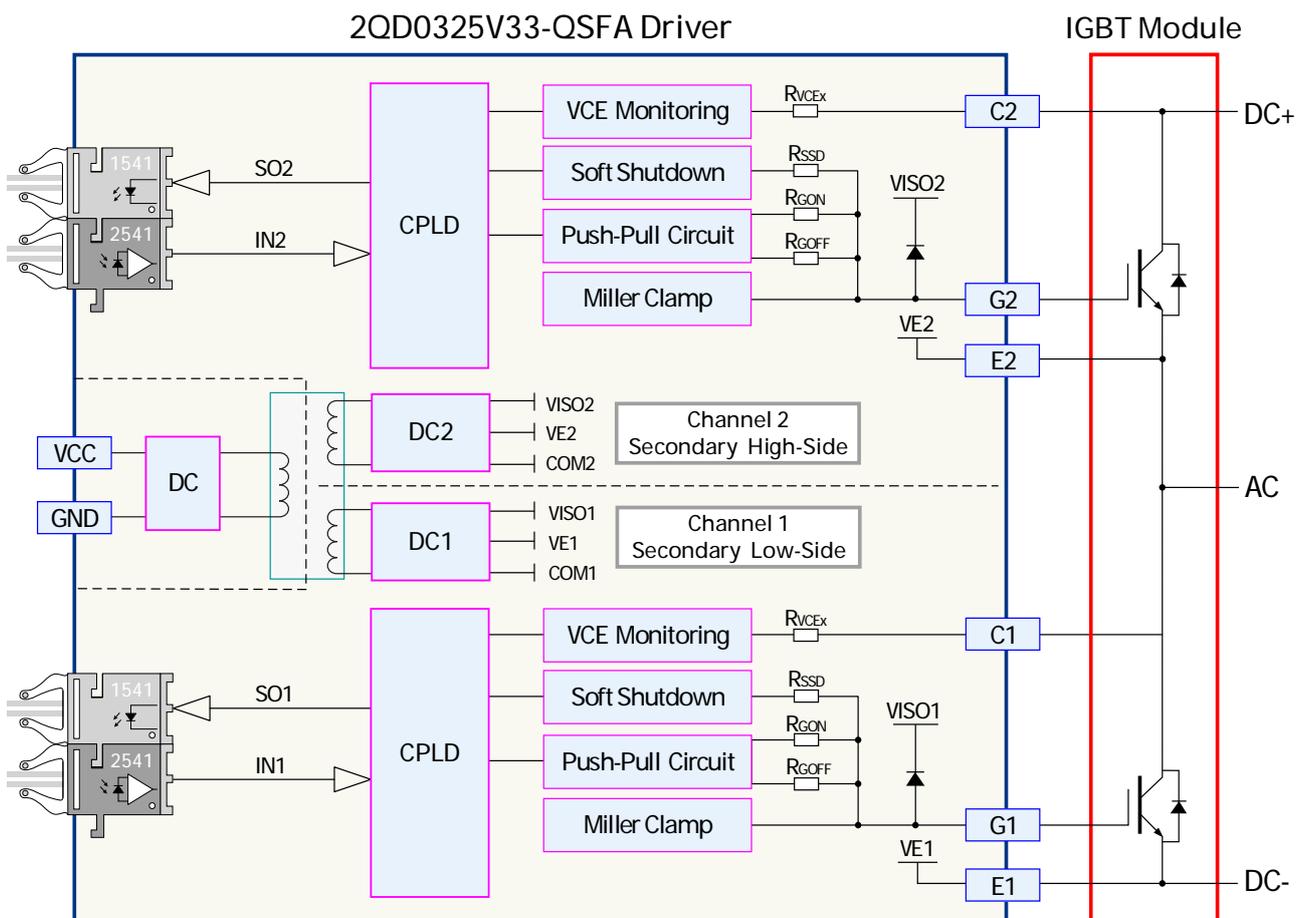
机械尺寸

机械尺寸图：参见[第 09 页](#)

型号定义



原理框图



接口定义

光纤接口定义

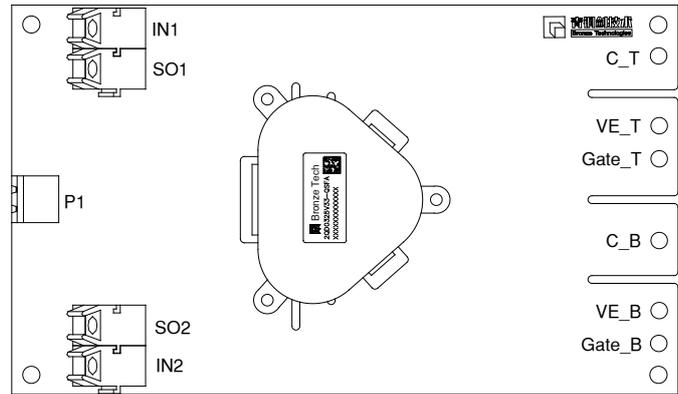
管脚	符号	说明
1	IN2	上桥臂驱动信号输入端
2	SO2	上桥臂故障信号输出端
3	IN1	下桥臂驱动信号输入端
4	SO1	下桥臂故障信号输出端

注：1) IN1、IN2 型号：HFBR-2541ETZ。
SO1、SO2 型号：HFBR-1541ETZ。

电压接口 -P1 端子定义

管脚	符号	说明
1	VCC	供电电源正 +
2	GND	供电电源地 -

注：1) 型号：MSTBA 2,5/2-G-5,08-RN, 菲尼克斯。



2QD0325V33-QSFA 接口示意图

参数

绝对限值

参数	MIN	MAX	UNIT
供电电源	14	30	V
门极驱动功率 ¹⁾		3	W
门极驱动电流		25	A
母线电压		2200	V
最大开关频率		5	kHz
原 / 副边绝缘电压		8000	V
副 / 副边绝缘电压		6000	V
运行温度 T _A	-40	85	°C
存储温度 T _s	-40	85	°C
湿度 ²⁾	5	95	%
海拔高度 ³⁾		2000	m

注：1) 在 T_A 允许温度范围内，单通道最大输出功率。
2) 不允许出现凝露现象。
3) 超过最大海拔高度应用请咨询深圳青铜剑技术公司。

输入

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
供电电压 V_{CC}	VCC to GND	14	24	30	V
供电电流	$V_{CC}=24\text{V}$ ，空载， $f_{sw}=0\text{kHz}$		110		mA
	$V_{CC}=24\text{V}$ ，空载， $f_{sw}=3\text{kHz}$ ，50% 占空比		125		mA
	$V_{CC}=24\text{V}$ ，300nF 负载， $f_{sw}=3\text{kHz}$ ，50% 占空比		175		mA
副边全压 $V_{CCO}^{1)}$	VISO to COM	23	25	27	V
副边正压 V^+	VISO to VE	14	15	16	V
副边负压 $V^{-2)}$	COM to VE	-11	-10	-9	V
注：1) 副边全压典型值为空载测试值。 2) 副边负压典型值为空载测试值。					

输出

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT	
门极输出电压 V_G	开通 ON-State	$V_{CC}=24\text{V}$ ，空载	14	15	16	V
	关断 OFF-State	$V_{CC}=24\text{V}$ ，空载	-11	-10	-9	V
门极电流 I_G	开通 ON-State	$V_{CC}=24\text{V}$ ， $R_{GON}=1\Omega$ ， $R_{GOFF}=1\Omega$			25	A
	关断 OFF-State	$V_{CC}=24\text{V}$ ， $R_{GON}=1\Omega$ ， $R_{GOFF}=1\Omega$			25	A

保护

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
原边欠压 保护阈值电压	触发 V_{CCUV+}	$V_{CC}=24\text{V}$ ，VCC-GND		12.3	V
	恢复 V_{CCUVR+}	$V_{CC}=24\text{V}$ ，VCC-GND		12.8	V
副边欠压 保护阈值电压 ¹⁾	触发 V_{UV-}	$V_{CC}=24\text{V}$ ，VISO-COM		18.2	V
	恢复 V_{UVR-}	$V_{CC}=24\text{V}$ ，VISO-COM		18.7	V
短路保护阈值电压 V_{REF}	$V_{CC}=24\text{V}$		10		V
短路保护响应时间 $t_{SC}^{2)}$	$U_{BUS} > 15\text{V}$	6	8	10	us
软关断时间 t_{SOFT}	90% V_{GE} to VE，300nF 负载		2		us
保护锁定时间 t_B			50		ms
注：1) 欠压保护逻辑参见图 7。 2) 短路保护时序图参见图 8。					

时序

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
传输延时 1)	开通延时 t_{ON}	$V_{CC}=24\text{V}$		400		ns
	关断延时 t_{OFF}	$V_{CC}=24\text{V}$		480		ns
输出信号上升时间 t_r		$R_{GON}=4.4\Omega$, $C_{LOAD}=33\text{nF}$		340		ns
输出信号下降时间 t_f		$R_{GOFF}=4.4\Omega$, $C_{LOAD}=33\text{nF}$		400		ns
注：1) 开通传输延时为输入光纤灯亮到门极信号上升沿 10%，关断传输延时为输入光纤灯亮到门极信号下降沿 90%。						

安全和抗干扰

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数		数值	UNIT
绝缘耐压 1)	原边 - 副边	8000	V
	副边 - 副边	6000	V
原边 - 副边 2)	隔离等效电容	30	pF
	电气间隙	22	mm
	爬电距离	35	mm
副边 - 副边	隔离等效电容	30	pF
	电气间隙	15	mm
	爬电距离	26	mm
ESD 静电防护 3)	接触放电	± 4	kV
	空气放电	± 8	kV
电快速瞬变脉冲群抗扰度		± 4	kV
注：1) 50Hz 交流电压，1min。 2) 电气间隙和爬电距离，按照 IEC 61800-5-1 标准设计。 3) EMC 测试按照 GB/T 17626 规范执行。			

特性曲线

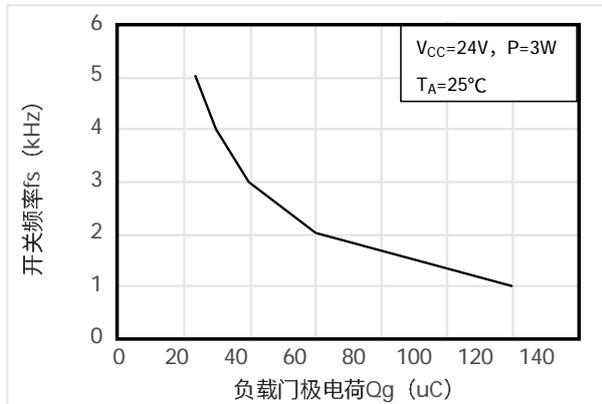


图1 负载门极电荷 vs 开关频率

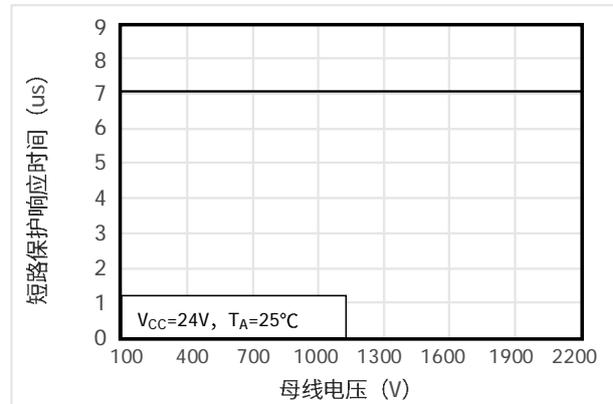


图2 短路保护响应时间 vs 母线电压

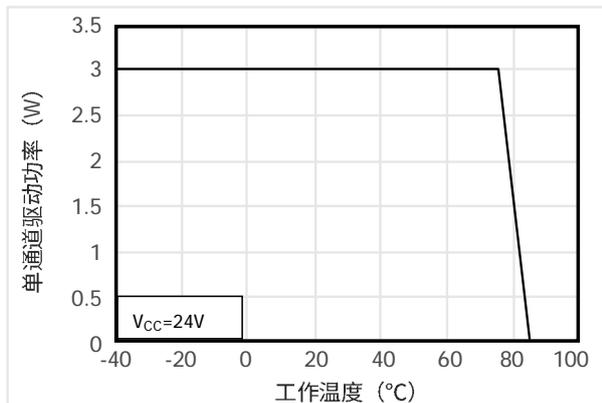


图3 驱动功率 vs 工作温度

功能描述

电源及电源监控

这款驱动器配有隔离 DC/DC 电源，可实现电源和门极驱动电路的电气隔离【见图 4】。

驱动器的原边及两个通道的副边都分别配备有电源监控电路，并实施欠压保护。

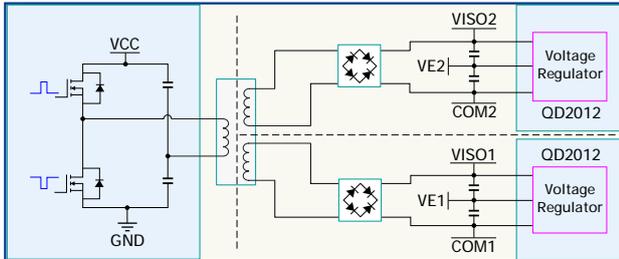


图 4 电源原理框图

副边电源监控：

副边电压在负载超载情况下，会发生电压下降。当副边电压 VISO (VISO 至 COM) 下降至欠压保护阈值 V_{CCUV} ，将启动副边欠压保护。

副边欠压保护首先会将本通道驱动锁定在关断状态，确保对应 IGBT 关断。另一通道不会受影响，仍能正常开关，其对应的 SO 信号为正常状态。控制系统需要及时检测 SO 信号，并根据策略发出系统闭锁命令。

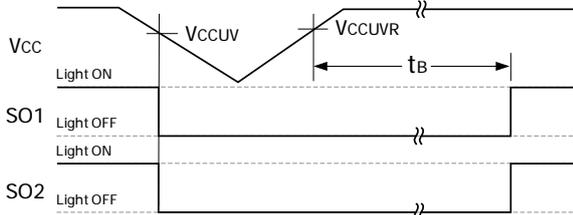


图 5 副边欠压保护逻辑图

触发信号 INx 输入

触发信号 INx 由光纤端口输入，灯亮为开通电平，灯灭为关断电平，逻辑关系【见图 6】。

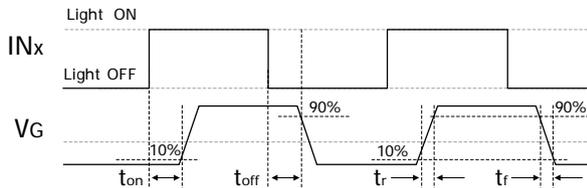


图 6 INx 开通关断逻辑图

保护输出信号输出

驱动器可通过光纤接口发送故障信号。光纤接口灯亮为 1，灯灭为 0，正常状态下故障信号为 1，发生故障后故障信号翻转，以信号做为起始点，每 2us 为一位，

数据长度 8 位，完成数据发送后以 50ms 低电平做为停止标志，结束信号发送，电平恢复为高电平，逻辑关系【见图 7】。故障列表见下表：

故障名称	故障编码
副边欠压故障	00100010
短路保护故障	00100000

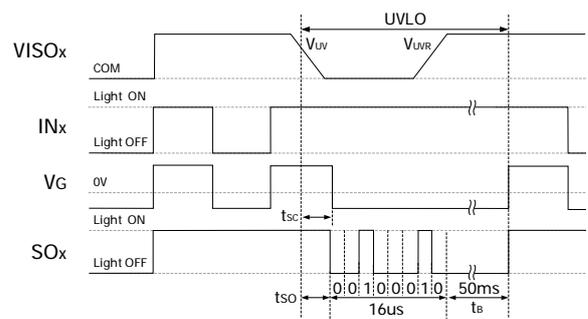


图 7 副边欠压保护时序图

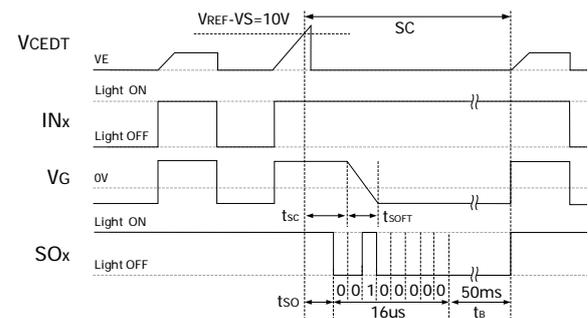


图 8 过流保护时序图

IGBT 的开通和关断

当需要开通 IGBT 时，驱动器内部芯片内的 QON 管打开，QOFF 管关闭，通过开通门极电阻 R_{GON} 对 IGBT 的门极进行充电，使 IGBT 开通。驱动器外部外置推挽输出，以拓展驱动电流能力。

当需要关断 IGBT 时，驱动器内部芯片内的 QOFF 管打开，QON 管关闭，通过关断门极电阻 R_{GOFF} 对 IGBT 的门极进行放电，使 IGBT 关断。

门极电阻 R_{GON} 和 R_{GOFF} 的选择，用户可咨询我们技术支持来进行设置，并进行出厂预配置。在安装到对应的 IGBT 模块上时，请确保已经安装上合适的门极电阻。

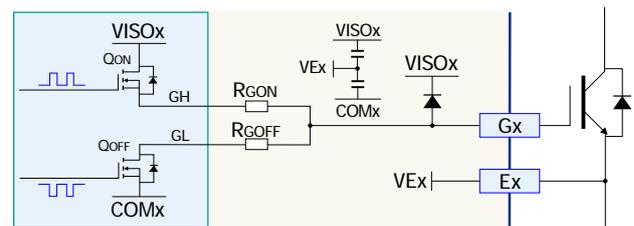


图 9 门极驱动电路图

IGBT短路保护

驱动器的 IGBT 短路保护使用 VCE 检测电路【见图 10】，两个通道各自独立。短路保护功能只在 IGBT 开通的时候有效；在 IGBT 关断状态，触发信号会将 QCE 打开，使得 VCEDT 钳位在 COMx（相对 VEX 为 -10V 左右），比较器不动作。

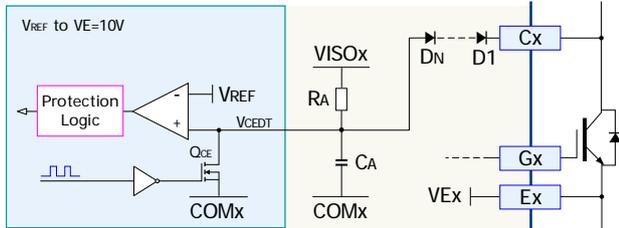


图 10 短路保护检测原理框图

正常开通时的表现：

当驱动器执行 IGBT 开通动作时，传输到副边的触发信号会将 QCE 关断，释放 VCEDT 钳位状态。此时 IGBT 的 VCE 仍处于高水平，将通过 RVCE 电阻串和 RA 电阻对 CA 电容进行充电，使得 VCEDT 电平逐渐抬升。随后 IGBT 开通，VCE 迅速下降至 VCE-SAT，VCEDT 也随之充电至 VCE-SAT【见图 11】。由于 VCE-SAT 远低于保护触发值 VREF，比较器不动作，保护不启动。

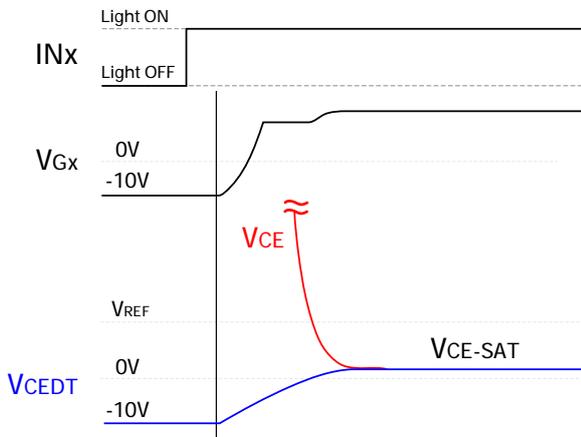


图 11 正常开通时 VCEDT 信号波形图

一类短路保护：

当 IGBT 发生一类短路（即直通）时，由于直通电流增长很快，IGBT 将迅速退饱和，VCE 很快回到高位。因此 CA 将会一直充电，使得 VCEDT 一直增长直到钳位至 VISOx。在此过程中，VCEDT 会越过 VREF，使得比较器翻转，从而启动短路保护逻辑。

短路保护逻辑会先把 IGBT 迅速关断，保障 IGBT 的安全。同时向原边发出信息，使得 SOx 管脚拉低，以表达出保护状态。保护状态将会锁定一个 tB 时间，然后自动恢复到正常状态。

两个通道的保护电路是相互独立的，所以在一个通道发生短路保护的情况下，另一通道仍然能够工作在正

常状态。控制系统需要及时检测 SO 信号，并根据策略发出系统闭锁命令。具体【见图 12】。

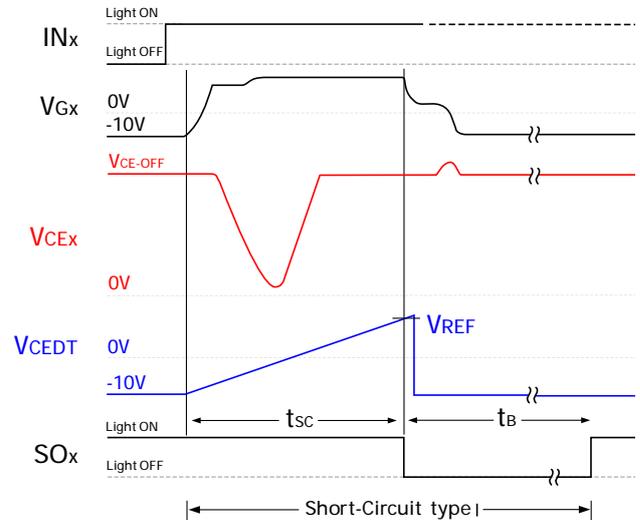


图 12 一类短路保护逻辑图

二类短路保护：

当 IGBT 发生二类短路（相间短路）时，由于短路回路阻抗较大，电流增长较缓慢。IGBT 仍能正常进入饱和状态，然后随着短路电流的增加，VCE 逐渐增加直至退饱和【见图 13】。驱动器只有在 IGBT 退饱和时才能检测出短路状态，启动短路保护。因此，二类短路保护的响应时间 tDT 会比一类短路保护响应时间要更长。

当 IGBT 在低母线电压下发生直通短路时，由于母线电压低导致直通电流较小，IGBT 也会呈现与二类短路保护相同的特征，相应的保护响应时间 tDT 也会加长。

注意：二类短路时，由于短路回路阻抗随机性较大，使得 IGBT 退饱和时刻不确定性较大。因此在 IGBT 保护动作前，有可能已产生较大的热量损耗而导致 IGBT 损坏。即，此种状态下驱动区短路保护并不能保证 IGBT 不损坏，系统需辅以过流保护等其他手段，以保障 IGBT 的安全。

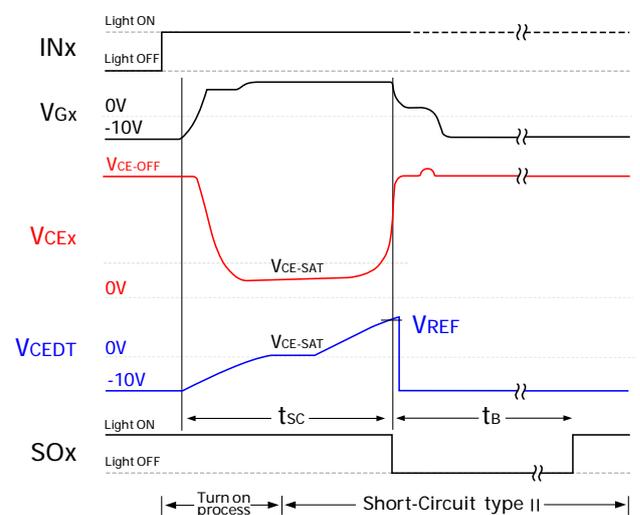
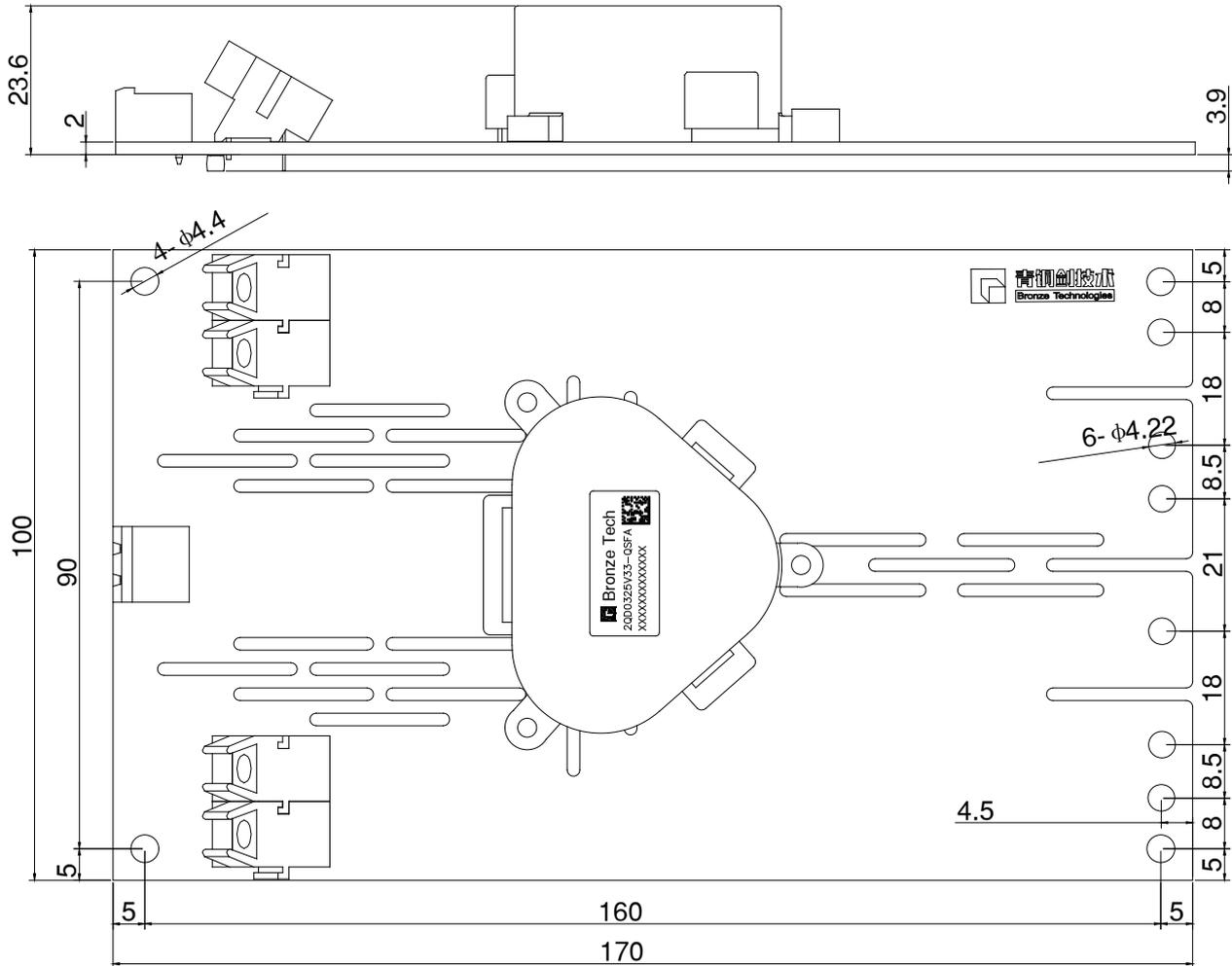


图 13 二类短路保护逻辑图

机械结构图



- 注：1) 图示单位为 mm；
2) 图中公差符合 ISO 2768-1。

版本说明

版本号	变更内容	修订日期
V1.0	新发布	05-May-2021
V1.1	说明书模板更新、内容优化	11-Aug-2022

注意事项

- IGBT 模块和驱动器的任何操作，均需符合静电敏感设备保护的通用要求，请参考国际标准 IEC 60747-1/IX 或欧洲标准 EN100015。为保护静电感应设备，要按照规范处理 IGBT 模块和驱动器（工作场所、工具等都必须符合这些标准）。



如果忽略了静电保护要求，IGBT 模块和驱动器可能都会损坏！

- 驱动器上电前，请确认驱动器和控制板连接可靠，无空接、虚接、虚焊现象。
- 驱动器安装后，其表面对大地电压可能会超过安全电压，请勿徒手接触！



使用中，可能危及生命，务必遵守相关的安全规程！

免责声明

青铜剑技术提供的技术和可靠性数据（包括数据手册等）、设计资源（包括 3D 模型、结构图、AD 模型）、应用指南、应用程序或其他设计建议、工具、安全信息和资源等，不包含所有明示和暗示的保证，包括对交付、功能、特定用途、适用性保证和不侵犯第三方知识产权的保证。

这些资源旨在为使用青铜剑技术产品进行开发的熟练工程师提供。为您全权负责：

- 为您的产品选择适当的青铜剑技术产品；
- 设计、验证和测试您的产品；
- 确保您的产品符合适用的要求。

青铜剑技术保留随时修改数据、文本和资料的权力，恕不另行通知。

请随时访问青铜剑技术网站 www.qtjtec.com 或微信公众号，以获取最新的资料。

青铜剑技术授权您仅在应用青铜剑技术产品的开发过程，使用相应的资源，禁止以其他方式复制和展示这些资源。青铜剑技术没有通过这些资源，授予任何青铜剑技术的知识产权或第三方知识产权许可。

对于因您使用这些资源而引起的任何索赔、损害、损失和成本，青铜剑科技不承担任何责任，并且有权追偿因侵犯知识产权而造成的损失。

